

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第3部門第1区分
【発行日】令和7年4月21日(2025.4.21)

【国際公開番号】WO2024/034267
【出願番号】特願2024-540295(P2024-540295)
【国際特許分類】
C30B29/36(2006.01)
【FI】
C30B29/36 A

10

【手続補正書】
【提出日】令和7年1月31日(2025.1.31)
【手続補正1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】

【請求項1】

20

主面を備え、
前記主面は、前記主面の外周縁から3mm以内の外周部と、前記外周部に囲まれた中央部とにより構成されており、
前記中央部における任意の正方領域において、 S_a として規定される算術平均高さは0.1nm以下であり、かつ、 S_{sk} として規定されるスキューネスは0以上であり、
前記正方領域の一辺の長さは、250 μ mである、炭化珪素基板。

【請求項2】

前記 S_{sk} として規定されるスキューネスは、0.4以下である、請求項1に記載の炭化珪素基板。

【請求項3】

30

前記 S_{sk} として規定されるスキューネスは、0.3以下である、請求項1に記載の炭化珪素基板。

【請求項4】

前記 S_a として規定される算術平均高さは、0.06nm以上である、請求項1に記載の炭化珪素基板。

【請求項5】

前記 S_a として規定される算術平均高さは、0.06nm以上であり、かつ、前記 S_{sk} として規定されるスキューネスは、0.3以下である、請求項1に記載の炭化珪素基板。

【請求項6】

40

前記主面の最大径は、150mm以上である、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の炭化珪素基板。

【請求項7】

請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の炭化珪素基板と、
前記炭化珪素基板上に設けられた炭化珪素エピタキシャル層と、を備えた、炭化珪素エピタキシャル基板。

【請求項8】

請求項7に記載の炭化珪素エピタキシャル基板を準備する工程と、
前記炭化珪素エピタキシャル基板を加工する工程と、を備えた、炭化珪素半導体装置の製造方法。

50